

2SA1135

シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

☆2SC2665とコンプリメンタリペアになります。

☆レジンモールドケース

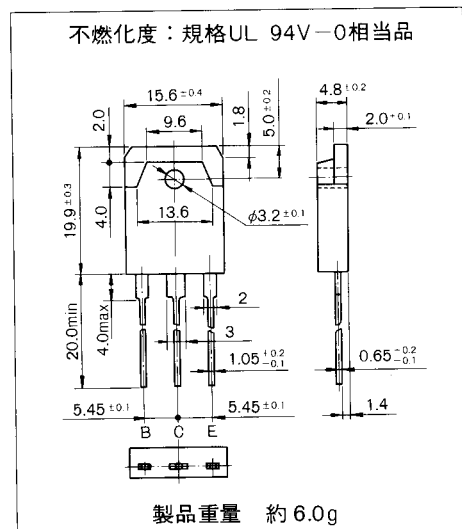
○一般用

外形図

単位: mm

最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	2SA1135	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-80	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-6	V
コレクタ電流	I_C	-4	A
ベース電流	I_B	-1	A
許容コレクタ損失	P_C	55 (フランジ温度 25°C)	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$



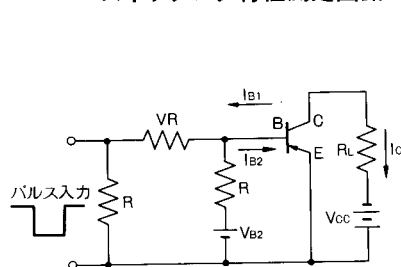
電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA1135	単位
最大コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -80\text{V}$	-1	mA
最大エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -6\text{V}$	-1	mA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -25\text{mA}$	-80	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -4\text{V}$ $I_C = -1\text{A}$	40 min	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2\text{A}$ $I_B = -0.2\text{A}$	-1.0 max	V
遮断周波数	f_T	$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_E = 0.2\text{A}$	10 typ	MHz

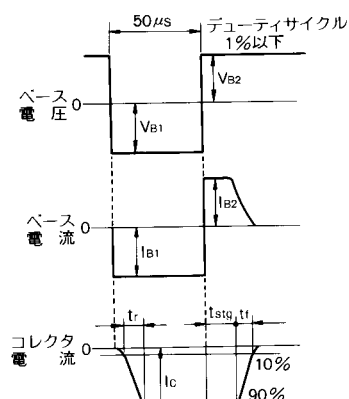
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	V_{B2} (V)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	t_r (μs)	t_{stg} (μs)	t_f (μs)
-6	3	-2	5	-300	300	1.0typ	0.4typ	0.15typ

スイッチング特性測定回路



測定波形



$P_C - T_a$ 定格

